

# 氮化镓Gan晶片生产厂家 2英寸氮化镓晶圆片工厂

产品名称	氮化镓Gan晶片生产厂家 2英寸氮化镓晶圆片工厂
公司名称	苏州恒迈瑞材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒迈瑞 型号:2英寸 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路60号（蠡盛大厦）507室（注册地址）
联系电话	15366208370

## 产品详情

### 氮化镓Gan晶片生产厂家 2英寸氮化镓晶圆片工厂

氮化镓（ Gallium Nitride ， GaN ）属于第三代半导体材料，其运行速度比传统Si硅技术加快了20倍，并且能够实现高出三倍的功率，用于尖端快速充电产品时，可以实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。氮化镓技术应用领域广阔，覆盖5G通信，人工智能，自动驾驶，数据中心，快充等等。

GaN基新型电子器件：氮化镓材料具有低的热产生率和高击穿电场，是研制高温大功率电子器件和高频微波器件的重要材料。随着 MBE技术在氮化镓材料应用中的进展和关键薄膜生长技术的突破，成功地生长出了GaN多种异质结构。用GaN材料制备出了金属场效应晶体管（ MEFET ）、异质结场效应晶体管（ HFET ）、调制掺杂场效应晶体管（ MODFET ）等新型器件。调制掺杂的AlGaN/GaN结构具有高的电子迁移率(2000cm<sup>2</sup>/vs)、高的饱和速度(1 × 10<sup>7</sup>cm/s)、较低的介电常数，是制作微波器件的优先材料；GaN较宽的禁带宽度(3.4eV) 及蓝宝石等材料作衬底，散热性能好，有利于器件在大功率条件下工作。